

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 1 区分  
 【発行日】令和 2 年 8 月 13 日 (2020.8.13)

【公表番号】特表 2019-524620 (P2019-524620A)  
 【公表日】令和 1 年 9 月 5 日 (2019.9.5)  
 【年通号数】公開・登録公報 2019-036  
 【出願番号】特願 2018-569161 (P2018-569161)  
 【国際特許分類】

C 0 1 B 32/188 (2017.01)

C 3 0 B 29/64 (2006.01)

【 F I 】

C 0 1 B 32/188

C 3 0 B 29/64

【手続補正書】  
 【提出日】令和 2 年 6 月 26 日 (2020.6.26)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

表面 ( 0 0 0 1 ) の結晶方位を持つ S i C 結晶を、連続して：

a )  $1 \times 10^{-9}$  m b a r 未満の圧力とし；

d ) 0 . 5 / 分から 1 0 / 分までの名目上のシリコン成長速度を生じる外部昇華源からのシリコン原子の流れの中で、 $5 \times 10^{-7}$  m b a r 以下の圧力下、1 3 0 0 から 1 8 0 0 までの温度でアニーリングすること

に供するという特徴を有する、シリコンカーバイドの表面にグラフェンを生産するための方法。

【請求項 2】

前記ステップ a ) と、前記ステップ d ) との間に、前記表面 ( 0 0 0 1 ) の結晶方位を持つ前記 S i C 結晶を、連続して：

b )  $1 \times 10^{-8}$  m b a r 以下の圧力下、3 0 0 から 9 0 0 までの温度でアニーリングすること；

c ) 0 . 5 / 分から 2 . 5 / 分までの名目上のシリコン成長速度を生じる外部昇華源からのシリコン原子の流れの中で、9 0 0 から 1 0 5 0 までの温度でアニーリングすること

にさらに供するという特徴を有する、請求項 1 のシリコンカーバイドの表面にグラフェンを生産するための方法。